

電子材料研究会

〔委員長〕羽路伸夫（横浜国立大学）

〔幹事〕岡田至崇（筑波大学），西川宏之（芝浦工業大学）

日時 平成20年9月27日（土）13:25～17:30

場所 東北大学 電気通信研究所 ナノ・スピン実験施設 4階 カンファレンスルーム（仙台市青葉区片平2-1-1，JR仙台駅より徒歩15分，仙台市営バスご利用の場合：仙台駅前西口バスプール11番・霊屋橋経由に乗車，片平丁小学校前の次，東北大正門前で下車にて徒歩約7分，地下鉄ご利用の場合：五橋駅下車，北2番の出入口より地上へ，徒歩約8分。地図：
<http://www.murota.riec.tohoku.ac.jp/lab/map.html>）

協賛 新IV族原子制御デバイス材料技術調査専門委員会（委員長 室田淳一，幹事 須田良幸，国井泰夫，幹事補佐 櫻庭政夫，竹廣 忍）

議題 テーマ「IV族系ヘテロ超微細デバイス材料技術の最新動向」

13:25～13:30

新IV族原子制御デバイス材料技術調査専門委員会委員長挨拶
室田淳一（東北大学）

13:30～15:10

EFM-08-24 SiGe/SiヘテロチャネルMOSFETにおける過渡チャージポンピング特性
土屋敏章（島根大学）
櫻庭政夫，室田淳一（東北大学）

EFM-08-25 高制御Si/SiGeエピタキシャル成長による超低消費電力SiGe HBTの実現
三浦 真，小田克矢（日立製作所）
島本裕巳（ルネサス北日本セミコンダクタ）
鷲尾勝由（日立製作所）

EFM-08-26 SiGe HBT ECL 位相周波数比較器を用いたKu帯低雑音PLL
堤 恒次，小牧昌彦，末松憲治（三菱電機）

EFM-08-27 SSON基板を用いたGAA型ひずみSi-MOSFETの試作とひずみのNBD評価
臼田宏治，中払 周，入沢寿史，守山佳彦，平下紀夫，手塚 勉，
杉山直治，山下良美，田岡紀之，木曾 修，山本豊二
（半導体MIRAI-ASET）
高木信一（半導体MIRAI-産総研ASRC，東京大学）

EFM-08-28 $\text{Ge}_{1-x}\text{Sn}_x$ バッファ層上への伸張歪Ge層形成と歪・転位構造制御
中塚 理，志村洋介（名古屋大学）
酒井 朗（大阪大学）
財満鎮明（名古屋大学）

15:10～15:30 休憩

15:30~17:30

- EFM-08-29 絶縁膜上における非晶質SiGeのインデント誘起固相成長
都甲 薫, 佐道泰造, 宮尾正信 (九州大学)
- EFM-08-30 真空一貫原子制御PVDプロセスによるTiO₂/HfSiO/SiO₂積層構造High-k絶縁膜の作製と電気特性評価
渡部平司, 有村拓晃 (大阪大学)
北野尚武 (大阪大学, キャノンアネルバ)
内藤裕一 (産業技術総合研究所)
奥 雄大 (大阪大学)
山口述夫, 小須田求 (キャノンアネルバ)
細井卓治, 志村考功 (大阪大学)
- EFM-08-31 トリメチルアミノシラン・オゾンを用いたシリコン酸化膜の原子層堆積法の素反応解析
廣瀬文彦, 成田 克 (山形大学)
宮 博信 (日立国際電気)
平原和弘 (信越化学)
木村康男, 庭野道夫 (東北大学)
- EFM-08-32 グラフェン形成のためのSi (110) 基板上3C-SiC (111) 成長
末光真希, 宮本 優, 半田浩之, 今野篤史 (東北大学)
- EFM-08-33 Si_{1-x}Ge_xエピタキシー技術と低次元デバイスへの応用
須田良幸, 花房宏明, 今野桂太, 大窪隆文, 功刀弘太, 大橋弘幸
(東京農工大学)
- EFM-08-34 ナノメートルオーダー歪SiGe/Si (100) ヘテロ構造によるホール共鳴トンネルダイオードの製作と高性能化
櫻庭政夫, 伊東良太, 瀬尾高広, 高橋邦彰, 室田淳一 (東北大学)

◎講演時間 1件当たり20分 (質疑応答5分を含む)